

منحنی‌های مشخصه ترانزیستور

روابط بین جریان‌ها و ولتاژ‌ها و تغییرات آنها در ترانزیستور و همچنین ضریب تقویت به عواملی چون درجه حرارت، فرکانس و غیر خطی بودن المان‌ها بستگی دارد. منظور از غیر خطی بودن، این است که نسبت تغییرات جریان‌ها و ولتاژ‌ها تابع یک معادله خطی ریاضی نیست. معمولاً از طریق ریاضی به سادگی نمی‌توان مقادیر را به دست آورد. بنابراین، از منحنی‌هایی که بیان کننده روابط بین جریان‌ها و ولتاژها است، استفاده می‌شود. این منحنی‌ها عبارت‌اند از:

(الف) منحنی مشخصه ورودی (b) منحنی مشخصه انتقالی (p) منحنی مشخصه خروجی
در ادامه بحث، درباره هر یک از سه منحنی ذکر شده توضیحاتی خواهیم داد. البته این منحنی‌ها برای آرایش امیتر مشترک ترسیم شده‌اند.

● منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور یا منحنی بیس امیتر

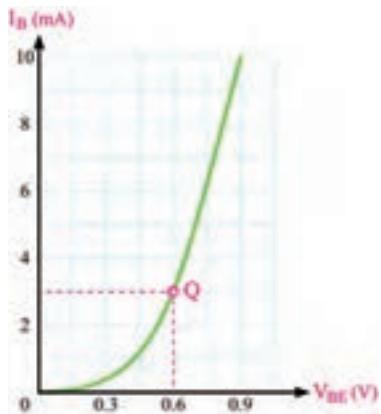
شکل منحنی مشخصه: در شکل ۵۵ منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور AC127 در حالت امیتر مشترک نشان داده شده است. این ترانزیستور از جنس زرمانیم است و به همین دلیل، جریان بیس نسبتاً زیادی دارد. منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور، بیان کننده مقدار جریان ورودی بر حسب ولتاژ ورودی است. چون مدار ورودی به یک دیود شباهت دارد، منحنی مشخصه آن نیز شبیه منحنی مشخصه ولت - آمپر دیود معمولی است.

اطلاعات قابل استخراج از منحنی مشخصه ورودی

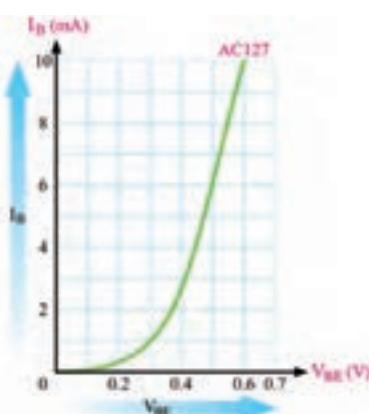
از منحنی مشخصه ورودی اطلاعات زیر را می‌توان استخراج نمود.

(الف) نقطه کار ورودی: به ازای یک V_{CE} معین با معلوم بودن هر یک از کمیت‌های V_{BE} یا I_B روى منحنی، نقطه کار ورودی مشخص می‌شود.

مثال ۱: در شکل ۵۶ به ازای ولتاژ $V_{BE} = 0.6\text{V}$ مختصات نقطه کار ورودی را مشخص کنید.
پاسخ: اگر مطابق شکل ۵۶ از نقطه $V_{BE} = 0.6\text{V}$ ولت خطی بر محور V_{BE} عمود کنیم، منحنی را در نقطه Q قطع می‌کند، از نقطه Q خطی بر محور I_B عمود می‌کنیم، محل تلاقی این خط با محور I_B مقدار I_B را در نقطه کار مشخص می‌کند.
 $V_{BE} = 0.6\text{V}$
 $I_B = 3\text{mA}$



شکل ۵۶



شکل ۵۵

ب) مقاومت دینامیک دیود بیس امیتر: اگر سیگنالی متنابض به بیس ترانزیستور اعمال کنیم، تغییر دامنه این سیگنال موجب آن می‌شود که افت پتانسیل دو سر پیوند بیس - امیتر، حول نقطه کار Q قدری تغییر کند. میزان این تغییرات در مقایسه با ولتاژ بایاس V_{BEQ} خیلی کم است؛ مثلاً اگر $7V$ ولت فرض شود، ممکن است این تغییرات بین دو مقدار $0.69V$ و $0.71V$ در نوسان باشد. تغییرات ولتاژ V_{BE} باعث تغییرات جریان بیس ترانزیستور خواهد شد. طبق تعریف، مقاومت دینامیکی دیود بیس امیتر با نسبت تغییرات ولتاژ بیس امیتر به تغییرات جریان بیس ترانزیستور برابر است. مقاومت دینامیکی دیود بیس امیتر را با r_π نشان می‌دهند.

$$r_\pi = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$$

● منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور

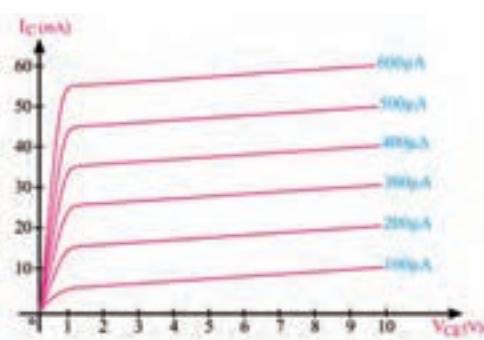
منحنی مشخصه انتقالی، رابطه بین جریان ورودی و جریان خروجی ترانزیستور را به ازای مقادیر ثابت V_{CE} نشان می‌دهد. در شکل ۵۷ منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور $7V$ BC را به ازای $V_{CE} = 5V$ مشاهده می‌کنید. از منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور می‌توان β_{DC} و β_{ac} یا β_{hfe} را به دست آورد.

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B} | V_{CE} \text{ ثابت}$$

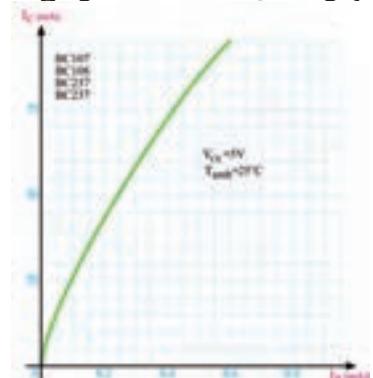
$$\beta_{ac} = h_{fe} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} | V_{CE} \text{ ثابت}$$

● منحنی‌های مشخصه خروجی ترانزیستور

منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور، رابطه بین جریان و ولتاژ خروجی را به ازای جریان ورودی معین نشان می‌دهد. اگر تقویت کننده امیتر مشترک باشد، جریان ورودی I_B و جریان خروجی I_C و ولتاژ خروجی V_{CE} خواهد بود تقریباً همه کارخانه‌های سازنده ترانزیستور این منحنی را در حالت امیتر مشترک ارائه می‌دهند. شکل ۵۸ منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور را به ازای جریان I_B ‌های مختلف ثابت نشان می‌دهد.



شکل ۵۸



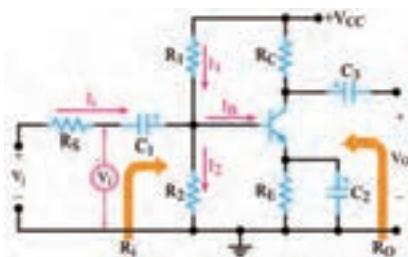
شکل ۵۷

- اطلاعات قابل استخراج از منحنی‌های مشخصه خروجی: از منحنی‌های مشخصه خروجی ترانزیستور اطلاعات زیر را می‌توان استخراج نمود.
- (الف) نقطه کار (ب) جریان نشستی (پ) بهره جریان (ت) امپدانس (مقاومت) خروجی ترانزیستور

تقویت کننده ترانزیستوری

• تقویت کننده امیتر مشترک (C.E.)

تقویت کننده امیتر مشترک، بیشترین کاربرد در انواع تقویت کننده‌ها را دارد. تقویت کننده امیتر مشترک علاوه بر تقویت جریان، تقویت ولتاژ را نیز انجام می‌دهد و به همین دلیل، در بسیاری از موارد، نسبت به تقویت کننده‌های دیگر برتری دارد. در مدار شکل ۵۹ یک تقویت کننده امیتر مشترک با بایاس سرخود را مشاهده می‌کنید.



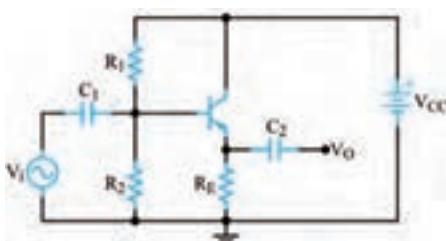
شکل ۵۹

• تقویت کننده بیس مشترک (CB)

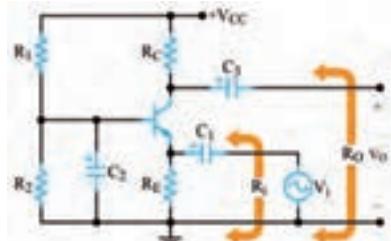
در تقویت کننده بیس مشترک، ورودی مدار، امیتر بیس و خروجی آن کلکتور بیس است. شکل ۶۰ یک تقویت کننده بیس مشترک با تغذیه سرخود را نشان می‌دهد.

• تقویت کننده کلکتور مشترک (CC)

اگر ورودی مدار تقویت کننده‌ای «بیس - کلکتور» و خروجی آن «امیتر - کلکتور» باشد. تقویت کننده در حالت کلکتور مشترک کار می‌کند. شکل ۶۱ یک تقویت کننده CC با تغذیه سرخود را نشان می‌دهد.



شکل ۶۱



شکل ۶۰

● مقایسه سه نوع آرایش تقویت‌کننده‌ها از نظر مشخصات

همان‌طوری که در مباحث قبلی مشاهده کردید، سه نوع آرایش تقویت‌کننده‌ها (CB, CE و CC) از نظر میزان بهره ولتاژ و جریان و مقاومت‌های ورودی و خروجی کاملاً باهم متفاوت هستند. همچنین بهره توان این تقویت‌کننده‌ها که از رابطه $A_P = A_V \times A_I$ محاسبه می‌شود نیز باهم متفاوت است. تقویت‌کننده امپیتر مشترک به علت داشتن بهره ولتاژ و بهره جریان نسبتاً زیاد بهره توان بسیار زیادی دارد به همین دلیل کاربرد آن در مدارهای مختلف الکترونیکی بسیار زیاد است. در جدول ۱ مشخصات این سه نوع آرایش را برای یک نوع ترانزیستور که از نظر بایاس تاحد امکان باهم تشابه دارند، مشاهده می‌کنید.

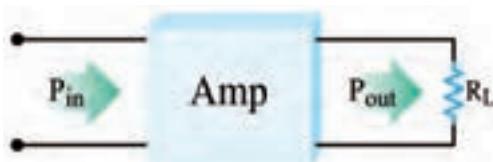
جدول ۱

کلکتور مشترک (CC)	بیس مشترک (CB)	امپیتر مشترک (CE)	
زیاد	کم و کوچک‌تر از واحد	متوسط	بهره جریان
کم و کوچک‌تر از واحد	زیاد	متوسط	بهره ولتاژ
زیاد و تقریباً برابر بهره ولتاژ	زیاد و تقریباً برابر بهره جریان	خیلی زیاد	بهره توان
زیاد	کم	متوسط	مقاومت ورودی
کم	زیاد	متوسط	مقاومت خروجی
۰°	۰°	۱۸۰°	اختلاف فاز

● بهره تقویت‌کننده بر حسب دسی‌بل (Decibel)

به شکل ۶۲ که بلوک دیاگرام یک تقویت‌کننده است توجه کنید. در این شکل توان داده شده به یک تقویت‌کننده را برابر P_{in} و توانی را که از آن گرفته می‌شود برابر P_{out} فرض می‌کنیم، طبق تعریف ده برابر لگاریتم اعشاری نسبت $\frac{P_{OUT}}{P_{IN}}$ تقویت‌کننده را ضریب تقویت توان بر حسب دسی‌بل می‌نامیم. این موضوع با رابطه لگاریتمی مقابل بیان می‌شود.

$$A_P(\text{dB}) = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$



شکل ۶۲

مثال ۶۲: در صورتی که توان وارد شده به شبکه شکل ۶۲ برابر یک وات و توان دریافتی از آن مساوی ۲ وات باشد، بهره قدرت این تقویت‌کننده چند دسی‌بل می‌شود؟

$$A_P = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} = \frac{2}{1} = 2 \quad \text{مرتبه}$$

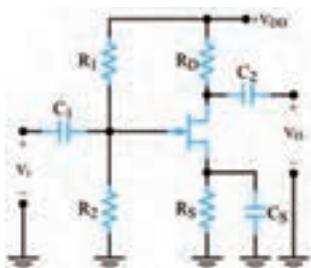
پاسخ: ابتدا AP را محاسبه می‌کنیم.

مقدار AP را در رابطه لگاریتمی دسی‌بل قرار می‌دهیم.

$$A_{P(\text{db})} = 10 \log \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} = 10 \log 2$$

Log ۲ = ۰/۳۰۱۰ است که برای سادگی محاسبات آن را برابر با ۰/۳ در نظر می‌گیریم و مقدار $A_{P(\text{db})} = 10 \times 0/3 = 3$ را بحسب دسی‌بل محاسبه می‌کنیم.

FET



شکل ۶۳

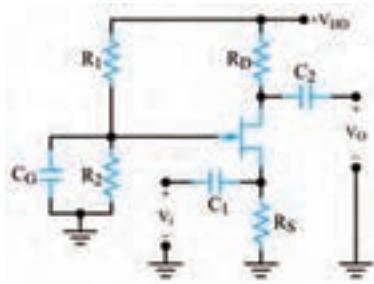
• تقویت‌کننده‌های سیگنال کوچک FET

یکی از کاربردهای مهم قطعات FET ساخت مدارهای تقویت‌کننده ولتاژ است. از یک FET ممکن است به صورت سورس مشترک، گیت مشترک یا درین مشترک استفاده کنیم. هر یک از این سه آرایش، مشابه ترانزیستور BJT مشخصات ورودی و خروجی خاصی دارد.

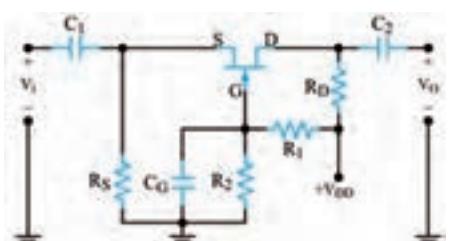
• مدار تقویت‌کننده سورس مشترک (Common source=CS) در شکل ۶۳ تقویت‌کننده سورس مشترک با ترانزیستور JFET کانال n را مشاهده می‌کنید.

• تقویت‌کننده گیت مشترک (Common gate=CG)

تقویت‌کننده گیت مشترک مشخصات مشابه تقویت‌کننده BJT بیس مشترک دارد. در شکل ۶۴ مدار یک تقویت‌کننده گیت مشترک را مشاهده می‌کنید. برای آنکه از این شکل در کم بهرتری داشته باشید، آن را به صورت شکل ۶۵ دوباره رسم کرده‌ایم. دقت کنید که محل هیچ‌کدام از اجزای مدار و یا جای ورودی و خروجی آن در این شکل تغییر نکرده است.



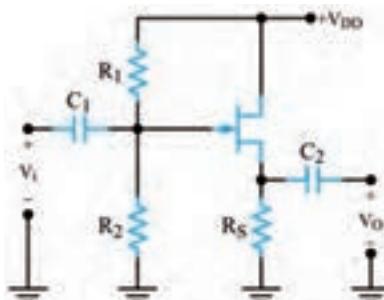
شکل ۶۵



شکل ۶۴

• تقویت کننده درین مشترک یا سورس پیرو (Common Drain=CD)

در شکل ۶۶ یک تقویت کننده درین مشترک دیده می‌شود. این مدار با مدار تقویت کننده BJT کلکتور مشترک مشابه است زیادی دارد. در این مدار، پایه درین در مقابل سیگنال ac زمین می‌شود. سیگنال ورودی به پایه گیت اعمال می‌شود و خروجی مدار از پایه سورس گرفته می‌شود.



شکل ۶۶

مقایسه تقویت کننده های BJT با تقویت کننده های FET

✓ ترانزیستور، هر آرایش که داشته باشد، عمل تقویت را انجام می‌دهد. هر یک از آرایش‌های ترانزیستور در مدار، مشخصات ورودی و خروجی ویژه‌ای را ایجاد می‌کند. آرایش CE مناسب‌ترین ترکیب است؛ زیرا بیشترین بهره ولتاژ و جریان را دارد و در نهایت قدرت بیشتری را فراهم می‌سازد.
☒ آرایش CB به علت داشتن مقاومت ورودی خیلی کم و مقاومت خروجی زیاد برای ایجاد تطبیق امپدانس بین یک مولد سیگنال با مقاومت داخلی کم و یک بار بزرگ مناسب است.

☒ این آرایش به دلیل داشتن پاسخ فرکانسی وسیع، در فرکانس‌های بالا نیز کاربرد دارد.
☒ آرایش CC به علت دارا بودن مقاومت خروجی خیلی کم اغلب به عنوان یک بافر (جداگر) برای تطبیق دادن بارهای کوچک در مدار استفاده می‌شود. ضمن اینکه مدار جریان را نیز تقویت می‌کند.

☒ طبقه نهایی تقویت کننده‌های صوتی را که باید بلندگوهای با امپدانس کم را تغذیه کند، به صورت کلکتور مشترک می‌بندند.

✓ ترانزیستورهای اثر میدان نیز مشابه‌تر زیادی با آرایش‌های BJT دارند. با این تفاوت که مقاومت ورودی FET بسیار بیشتر از مقاومت ورودی BJT است. بهطور کلی از نظر آرایش، مدارهای FET با BJT به صورت زیر مقایسه می‌شوند.

- آرایش CS مشخصاتی مانند آرایش CE دارد.
- مشخصات آرایش CG مانند آرایش CB است.
- آرایش CD مشخصاتی مانند آرایش CC دارد.

بررسی پروژه‌ها

• تقویت کننده ۱۰ وات

سیگنال خروجی میکروفون‌ها بسیار ضعیف هستند. چنانچه آنها را مستقیم به آمپلی‌فایر وصل

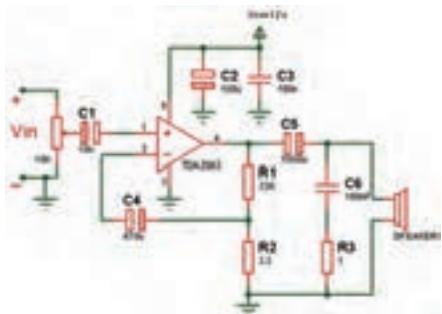
کنید سطح سیگنال خروجی بسیار کم خواهد بود. به طوری که ممکن است صدا به خوبی شنیده نشود. به همین دلیل باید قبل از اتصال میکروفون به تقویت‌کننده، کمی سطح سیگنال آن را توسط مدار پری آمپلی‌فایر تقویت کرده و سپس برای تقویت نهایی به مدار تقویت‌کننده اصلی متصل نمود. هنگام اتصال میکروفون به میکروکنترلر نیز باید از پری آمپلی‌فایر استفاده کرد. با توجه به اینکه خروجی میکروفون‌ها بسیار ضعیف بوده و سیگنال تولید شده توسط آن به طور مستقیم توسط ورودی میکروکنترلر تشخیص داده نمی‌شود باید آن را ابتدا توسط پری آمپلی‌فایر تقویت کرده و سپس به ورودی میکروکنترلر متصل نمود.

• بلوک دیاگرام آی - سی ۲۰۰۳

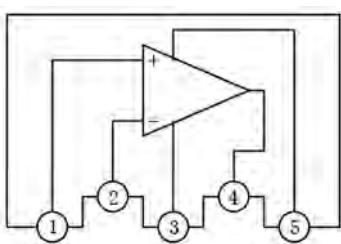
شکل ۶۷ بلوک دیاگرام آی - سی ۲۰۰۳ TDA۲۰۰۳ را نشان می‌دهد. نقش پایه‌های این مدار به شرح زیر است.

✓ پایه‌های ۱ و ۲: ورودی ✓ پایه‌های ۳ و ۵: خروجی ✓ پایه‌های ۴: تنظیم

در نقشه شماتیک مدار تقویت‌کننده، ولومی برای کنترل شدت صوت قرار داده نشده است. به این دلیل که قرار است در ادامه خروجی بُرد پخش Mp^3 مستقیماً به ورودی این مدار متصل گردد. اگر برای مصارفی استفاده می‌کنید که به ولوم نیاز دارد، کافی است به صورت شکل ۶۸ مدار را به کار ببرید.



شکل ۶۸ - مدار تقویت‌کننده با ولوم کنترل شدت صوت



شکل ۶۷ - بلوک دیاگرام ۲۰۰۳

در این مدار با تنظیم ولوم می‌توانید شدت صدای خروجی را کنترل نمایید. ولوم دارای سه پایه است. سیگنال ورودی به یکی از پایه‌های ثابت داده می‌شود و پایه ثابت دیگر به زمین مدار متصل می‌گردد. حال می‌توانید از پایه متغیر (پایه وسط) سیگنال قابل کنترل را دریافت کنید. از این روش برای ورودی تقویت‌کننده‌های صوتی دیگر نیز می‌توانید استفاده نمایید.

شست و شوی بُردهای الکترونیک به روش التراسونیک

✓ بُردهایی که در وسایل مختلف از جمله تلویزیون، پرینتر و دستگاه کپی استفاده می‌شوند بعد از مدتی آلوده به گرد و خاک می‌شوند و باید پاک شوند. همین طور بُردهای تازه مونتاژ شده نیز نیاز به تمیز کاری دارند. یکی دیگر از روش‌های از بین بردن آلاینده‌ها روش فراصوت (Ultrasonic) است. التراسونیک به امواجی گفته می‌شود که فرکانس آن بالاتر از محدوده شنوایی گوش انسان است. بُردهای آلوده و گرد و غبار گرفته داخل محلولی شیمیایی قرار داده می‌شوند و سپس توسط امواج مافق صوت شست و شو شود. بعد از آن خشک می‌شوند. شکل ۶۹ نمونه‌ای از یک بُرد آلوده به گرد و خاک را نشان می‌دهد. از این روش بیشتر در کارخانه‌ها و صنایع استفاده می‌شود.

در ابعاد کوچک‌تر و مصارف خانگی معمولاً از دستگاه‌های دمنده هوا (blower) که در شکل ۷۰ مشاهده می‌نمایید، برای از بین بردن گرد و خاک استفاده می‌شود.



شکل ۷۰- برد آلووده به گرد و خاک

✓ از کاربردهای دیگر امواج آلتراسونیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

(الف) تمیزکاری قطعات هوپیما (ب) کنترل عفونت (پ) فاصله‌یابی (به عنوان مثال سنسور دندنه عقب اتومبیل)

عملکرد مدار کلید الکترونیکی

✓ در این مدار از تراشه CD4013 استفاده شده است. هر زمان که کلید فشار داده شود پایه شماره ۱ این تراشه تغییر وضعیت می‌دهد. چون این خروجی دارای جریان ضعیفی است، از یک ترانزیستور برای تقویت جریان استفاده شده است. این ترانزیستور جریان لازم برای راهاندازی رله را فراهم می‌کند. قطع و وصل رله می‌تواند سبب قطع و وصل وسایل دلخواه شما شود. البته در این حالت باید به جریان مجاز کن tact های رله دقت نمایید.

● قسمتی از برگه اطلاعاتی مازول ۱ SR50

Spectification:

- Voltage: 5V - 20V
- Power Consumption: 65mA
- TTL output: 3.3V. 0V
- Delay time: 0.2 sec
- Trigger methods: L - disable repeat trigger, H enable repeat trigger
- Sensing range: less than 120 degree, Within 7 meters
- Temperature: -15 ~ +70
- Dimension: 32×24 mm, distance between screw 28mm, M2, Lens dimension in diameter: 23mm

Application

Automatically sensing light for Floor, bathroom, basement, porch, warehouse, Garage, etc, ventilator, alarm, etc.

● قسمتی دیگر از برگه اطلاعاتی مازول ۱ SR50: (نحوه کالیبره کردن مازول)

Instructions

Induction module needs a minute or so to initialize. During initializing time, it will output 0-3 times. One minute later it comes into standby. Keep the surface of the lens from close lighting source and wind, which will introduce interference.

✓ پایه شماره ۴ آی - سی ۵۵۵ زمانی که به زمین متصل باشد، خروجی ۵۵۵ غیرفعال و چنانچه این پایه به مثبت وصل شود خروجی فعال خواهد شد. در این مدار پایه مذکور توسط یک مقاومت ۱۰ کیلو اهم به زمین متصل شده است (به این مقاومت پایین کش یا Pull-Down می‌گویند) و آی - سی غیرفعال است.

✓ حال اگر به هر دلیل این پایه به ولتاژ مثبت متصل شود خروجی فعال می‌شود. در این مدار از مژول PIR استفاده شده است. اما شما می‌توانید هر مدل مژولی که با حس کردن یک کمیت، خروجی «یک» تولید می‌کند را به این پایه وصل کنید. به عنوان مثال می‌توان با اتصال یک مژول تشخیص گاز، این مدار را به «مدار هشداردهنده گاز» تبدیل کرد.

- دو مدل از این مژول‌ها در جدول ۲ نمایش داده شده است.

جدول ۲: مژول گاز

شکل	نام مژول (سنسور)
	LPG, Propane, iso, butane MQ-6 حساس به گازهای
	MQ-2 حساس به کلیه گازهای مشتعل و دود

تفاوت بین رگولاتورهای ۷۸L۰۵ و ۷۸L۰۵

برای جریان‌های بالاتر، و ۷۸L۰۵ برای جریان‌های پایین‌تر استفاده می‌شود. به قسمتی از دیتابیشیت این دو نوع رگولاتور در شکل‌های ۷۱ و ۷۲ دقت کنید.

● چنانچه بخواهید از یک تقویت‌کننده صوتی استریو استفاده کنید، باید از آی‌سی‌های TDA۲۰۰۵ و TDA۲۰۰۷ استفاده نمایید. با جستجو در سایت Alldatasheet. com دیتابیشیت این آی‌سی‌ها را دانلود و سپس از مدارات موجود در آنها برای ساخت استفاده نمایید.

FEATURES

Output Current Up to 100mA

No External Components

Internal Thermal Overload Protection

internal Short-Circuit Limiting

Output Voltage of 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, and 24V.

Moisture Sensitively Level 3

شکل ۷۱- برگه اطلاعات ۷۸L۰۵

Features

- Output Current up to 1A

- Output Voltages of 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24V

- Thermal Overload Protection

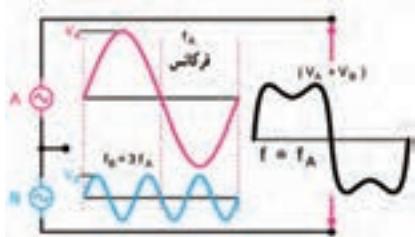
- Short Circuit Protection

- Output Transistor Safe Operating Area Protection

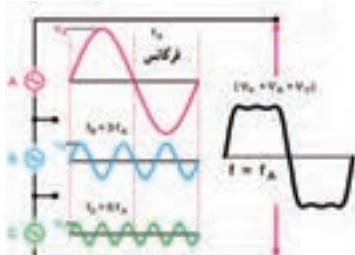
شکل ۷۲- برگه اطلاعات ۷۸L۰۵

هارمونیک‌های یک موج

مضرب‌های فرد و زوج از فرکانس اصلی را در اصطلاح هارمونیک (Harmonic) می‌نامند. هر موج غیرسینوسی از ترکیب تعدادی موج سینوسی به وجود می‌آید. این امواج توسط دستگاه مخصوص (دستگاه طف‌نما) از یکدیگر قابل تفکیک هستند. اگر فرکانس اصلی یک موج غیرسینوسی را f_A در نظر بگیریم، هارمونیک‌ها به ترتیب $1f_A$, $2f_A$, $3f_A$, $4f_A$ و... است. هرقدر شماره هارمونیک افزایش می‌یابد، مقدار دامنه آن کم می‌شود.



شکل ۷۳



شکل ۷۴

- **هارمونیک‌های موج مربعی متقارن**
هر موج مربعی متقارن فقط دارای هارمونیک‌های فرد است. یعنی اگر موج اصلی دارای فرکانس f_A باشد، هارمونیک‌ها دارای فرکانس $1f_A$, $3f_A$, $5f_A$, $7f_A$ و... هستند. مثلًاً اگر فرکانس اصلی برابر ۱MHZ باشد هارمونیک‌ها دارای فرکانس ۱MHZ، ۳MHZ، ۵MHZ و... است.

در شکل ۷۴ ترکیب هارمونیک اول و سوم از موج مربعی نشان داده شده است. در شکل ۷۴ ترکیب هارمونیک اول، سوم و پنجم از موج مربعی رسم شده است. مشاهده می‌کنید در این حالت موج حاصل از هارمونیک‌ها به موج مربعی نزدیک‌تر است.

مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

● ساختمان هوشمند

- ✓ «ساختمان هوشمند بنایی است که در آن از آخرین فناوری‌ها استفاده شده باشد».
- ✓ در ساختمان هوشمند دسترسی و کنترل تمامی امکانات موجود در آن از راه‌های سیستم کنترل مرکزی، امواج رادیویی و کنترل از راه دور میسر می‌شود و شما قادر به کنترل هوشمند تمامی دستگاه‌های موجود در ساختمان و آگاهی از وضعیت کارکرد آنها هستید.
- ✓ در یک ساختمان هوشمند با بهره گرفتن از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری مدرن این امکان را می‌توان فراهم آورد تا بتوان اجزا و تجهیزات مختلف را به‌طور خودکار کنترل کرد و

از این شرایط در جهت بهبود کیفی شرایط زیستی استفاده کرد برای مثال این سیستم به صورت خودکار با روشن و خاموش کردن سیستم‌های تهویه، هوای مناسب و مطبوعی را برای ساکنین به وجود می‌آورد و این حالت در راستای کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان (مبحث نوزدهم - مقررات ملی ساختمان) خواهد بود.

بیشترین مصرف انرژی در ساختمان توسط سیستم روشنایی صورت می‌گیرد که با هوشمندسازی این سیستم می‌توان از اتلاف انرژی تا حد زیادی جلوگیری کرد. این عمل با ترکیب روشنایی روز و روشنایی مصنوعی به بهترین نحو و خاموش کردن چراغ‌ها در زمان بدون مصرف به وجود می‌آید. شکل ۷۵ مدیریت هوشمند در یک ساختمان را نشان می‌دهد.



شکل ۷۵- مدیریت هوشمند در یک ساختمان

مدیریت مصرف انرژی در ساختمان هوشمند تأثیر بسیاری در صرفه‌جویی مصرف انرژی دارد. واپسیه کردن نور و سیستم تهویه به حضور شخص و برنامه‌ریزی بهینه دمای اتاق‌ها در ساعات مختلف شباهه روز از مصادیق مدیریت مصرف انرژی هستند.

جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب به داخل ساختمان در تابستان توسط کنترل اتوماتیک پرده و کرکره، سبب صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی برای دستگاه‌های سرمایشی می‌شود. سیستم‌های روشنایی، ایمنی، در و پنجره، پرده، کرکره و سایه‌بان، گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع، صوتی، تصویری، آفون تصویری، آبیاری خودکار، کنترل تأسیسات استخراج، سونا و جکوزی و سیستم‌های ارتباطی (تلفن، پیام‌گیر، تلفن سانترال و اینترنت) و وسائل الکتریکی از مهم‌ترین وسائل و تجهیزات قابل کنترل در ساختمان‌های هوشمند هستند.

در ساختمان هوشمند با بررسی نیازهای مختلف ساختمان سیستم کنترلی مورد نیاز برای ساختمان طراحی و ساخته می‌شود. به طور کلی نیازهای یک ساختمان عبارت اند از:

• روشنایی

یکی از عمدۀ ترین کنترل‌های مورد نیاز ساختمان‌های هوشمند، کنترل روشنایی فضا است که با ایجاد روشنایی متناسب با محیط و نوع فعالیت، موجب ایجاد آرامش افراد و محیط خواهد شد. روش و خاموش کردن لامپ‌ها و تنظیم میزان روشنایی آنها در کنار سایر اقدامات پیش‌بینی شده مثل تنظیم پرده‌ها با توجه به نور محیط، تنظیم سایه‌بان‌های پنجره با توجه به آب و هوا و کنترل سیستم روشنایی اضطراری موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود.

• تهویه

از کنترل‌های مورد نیاز ساختمان‌های هوشمند، مناسب‌سازی هوای داخل و صرفه‌جویی در انرژی مصرفی سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی ساختمان می‌باشد که با اعمال تنظیمات مناسب و کنترل دمای محیط، میزان اکسیژن، رطوبت و فشار می‌توان از تهویه مناسب بهره‌مند شد.

نمونه‌گیری وضعیت آب و هوای (دما، وضعیت جوّی، میزان باد) فضاهای مخالف ساختمان به عنوان رودی و تنظیم رطوبت محیط، فشار و اکسیژن هوای ساختمان به عنوان خروجی سیستم بوده و با روش خاموش کردن وسایلی مانند هواسازها، فن‌کوئل، اسپلیت و کولر صورت می‌گیرد.

• ایمنی

کنترل سیستم ایمنی در ساختمان‌های هوشمند جهت محافظت از سلامتی افراد و ساختمان در مقابل خطرات احتمالی صورت می‌گیرد. این سیستم به کنترل مشخصه‌های اتفاقات غیرمتربقه از قبیل آتش‌سوزی، آب گرفتگی، نشت گاز و سایر موارد می‌پردازد و با آگاه‌سازی افراد ذیربط و انجام اقدامات لازم، مانع ایجاد خسارت می‌شود.

از وظایف این بخش، کنترل سیستم اعلام حریق و اطفای آن، کنترل دود و آب گرفتگی، کنترل نشت گاز، تشخیص مواد شیمیایی و نظایر آن است که در صورت وقوع حادثه با آتش‌نشانی و پلیس و مراکز مربوطه تماس برقرار نموده و هم‌زمان با انجام اقدامات لازم مانند باز و بسته کردن درهای اضطراری سبب کاهش خسارت می‌شود.

• تردد

از دیگر وظایف سیستم هوشمند ساختمان، کنترل تردد افراد مجاز ساختمان و جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز است. کنترل وضعیت باز و بسته بودن درها و تشخیص تردد از طریق اثر انگشت، صفحه کلید، کارت وغیره، آیفون تصویری و ذخیره تصویر مراجعه کنندگان و دوربین‌های مداربسته صورت می‌گیرد که شبیه‌سازی حضور در منزل یکی از این سیستم‌ها است.

• خدمات رفاهی

اگرچه در حال حاضر، این دسته از خدمات، تجملی بوده و برای سرگرمی، آسایش و رفاه حال

ساکنین ارائه می‌شوند. ولی به نظر می‌رسد در سال‌های بعد به عنوان مجموعه‌ای از خدمات، مورد استفاده عمومی قرار گیرد. بهمین دلیل در حال حاضر این خدمات در تمام ساختمان‌های هوشمند دیده نمی‌شوند و اکثرًا در منازل و مکان‌های شخصی ملاحظه می‌شوند.

● انواع خدمات رفاهی

- توزیع سیستم‌های رسانه‌ای مثل اینترنت، تلویزیون.
- کنترل وسایل آشپزخانه مانند مایکروفر، فر، چای‌ساز و گاز
- کنترل سیستم‌های صوتی و تصویری با قابلیت کنترل در هر فضایی از جمله تعویض منبع صوتی یا تصویری، تنظیم شدت صدا، تغییر در فرکانس صدا (صدای زیر و بم).
- روشن کردن پکیج و تعیین حرارت، اطلاع‌رسانی دمای مطلوب
- تنظیم شرایط کاری آبگرمکن، یخچال (دما و حتی سفارش مواد مصرفی)، ماشین لباس‌شویی و گاز

● تأسیساتی

- سیستم هوشمند مدیریت می‌تواند سایر تجهیزات و تأسیسات ساختمان را مانند آبیاری خودکار، باز و بسته کردن درب ورودی و پارکینگ، پمپ آب کنترل و برنامه‌ریزی کند. شکل ۷۶ بخش‌هایی که در یک ساختمان به صورت هوشمند می‌تواند مدیریت شود را با نماد نشان می‌دهد.



شکل ۷۶- مدیریت هوشمند در یک ساختمان

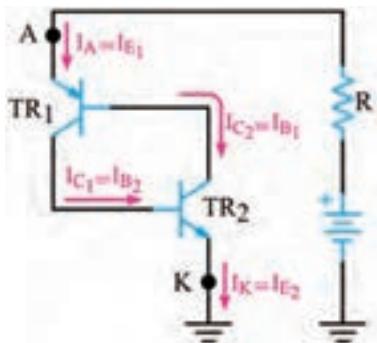
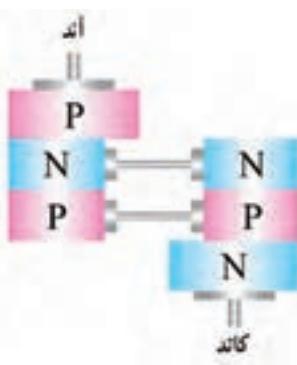
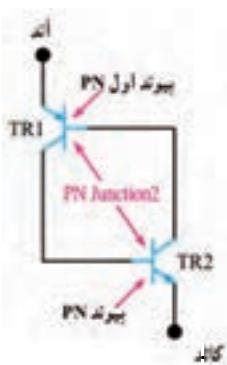
قطعات الکترونیک صنعتی

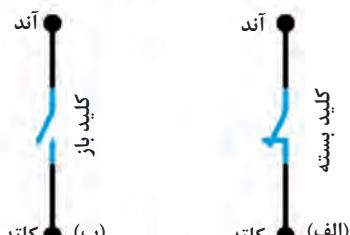
● مدار معادل دیود چهار لایه

☑ می‌توان دیود چهار لایه را به صورت شکل ۷۷ برش داد و آن را به دو بخش مطابق شکل ۷۸ تقسیم نمود. همان طور که در شکل ۷۸ مشاهده می‌شود نیمه سمت چپ معادل یک ترانزیستور PNP و نیمه سمت راست یک ترانزیستور NPN است. لذا طبق شکل ۷۹ دیود شاکلی از دو ترانزیستور NPN و PNP تشکیل می‌شود. این دو ترانزیستور به یکدیگر کوپلاز مستقیم شده‌اند. این مجموعه به قفل ترانزیستوری (Latch) معروف است.

☑ همان طور که در شکل ۸۰ مشاهده می‌کنید، کلکتور TR_۱ به بیس TR_۲ و کلکتور TR_۲ به بیس TR_۱ اتصال دارد. این نوع اتصال باعث فیدبک مثبت می‌شود و می‌تواند شرایطی را به وجود آورد تا عمل قفل شدن ترانزیستوری انجام پذیرد.

☑ در این حالت هر تغییری در جریان در هر نقطه‌ای از حلقه فیدبک، تقویت می‌شود و پس از تقویت با همان فاز به نقطه شروع برمی‌گردد. به شکل ۸۰ توجه کنید.





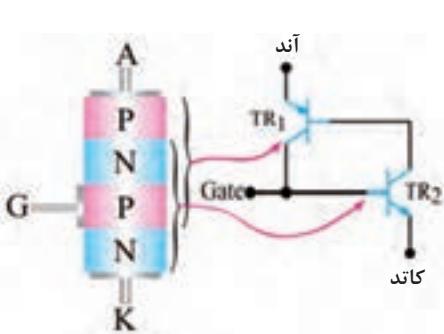
شکل ۸۱

☒ مثلاً اگر جریان بیس TR₂ افزایش یابد، جریان کلکتور TR₂ افزایش می‌یابد و منجر به جاری شدن جریان بیشتری در بیس TR₁ می‌شود و در ادامه جریان کلکتور TR₁ بیشتری را ایجاد می‌کند. در نتیجه، بیس TR₂ با شدت بیشتری راه اندازی می‌شود. این روند یعنی بالا رفتن جریان‌ها ادامه می‌یابد تا این که در دو ترانزیستور به اشباع می‌رسند. در این حالت دیود چهارلایه قفل می‌شود و طبق شکل الف - ۸۱ مانند یک کلید بسته یا وصل عمل می‌کند.

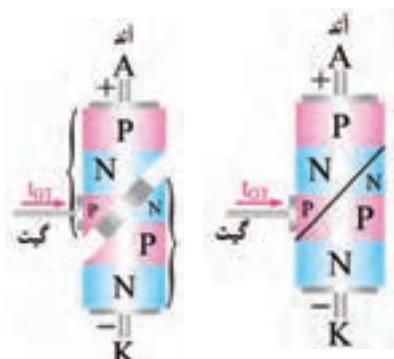
☒ حال اگر عاملی باعث کاهش جریان بیس TR₂ شود، جریان کلکتور TR₂ کاهش می‌یابد و جریان بیس TR₁ را کم می‌کند. کاهش جریان بیس TR₁ جریان کلکتور کمتری را به وجود می‌آورد و در ادامه، جریان بیس TR₂ را به مقدار بیشتری کاهش می‌دهد. این عمل ادامه می‌یابد تا اینکه هر دو ترانزیستور به حالت قطع می‌روند. در این شرایط دیود شاکلی مجدداً قفل شده و طبق شکل ب - ۸۱ شبیه به یک کلید باز (قطع) عمل می‌کند.

● مدار معادل SCR و عملکرد آن (SCR Equivalent Circuit)

☒ برای درک بهتر عملکرد SCR می‌توان ساختمان کریستالی آن را مطابق شکل ۸۲، برش داد و آن را به دو نیمه جداگانه مانند شکل ۸۳ تقسیم نمود. مانند شکل ۸۴ یک نیمه از SCR معادل یک ترانزیستور PNP و نیمه دیگر آن معادل یک ترانزیستور NPN است که کلکتور و بیس آنها بهم کوپلazer مستقیم شده‌اند.



شکل ۸۴



شکل ۸۳

شکل ۸۲

● روشن کردن SCR

هم‌زمان یک سیگنال راه انداز به پایه گیت آن اعمال کنیم. به منظور تشریح کار SCR چند حالت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

☒ حالت اول - جریان و ولتاژ گیت صفر است: در این حالت جریان بیس TR₂ مساوی صفر و جریان IC₀ تقریباً معادل IC₀ می‌شود. از طرفی چون جریان IC₀ بسیار ناچیز است، نمی‌تواند ترانزیستور TR₁ را روشن کند. در این شرایط هر دو ترانزیستور در حالت خاموش باقی‌مانند و طبق شکل ۸۵ بین آند و کاتد امپدانس بالایی قرار می‌گیرد. که به معنای باز بودن مدار است.

حالت دوم – اعمال پالس مثبت به گیت: هرگاه یک پالس مثبت V_G را به گیت اعمال کنیم و دامنه V_G را به اندازه کافی بزرگ انتخاب نماییم. به طوری که بتواند TR_2 را روشن کند، شرایط زیر رخ می‌دهد.

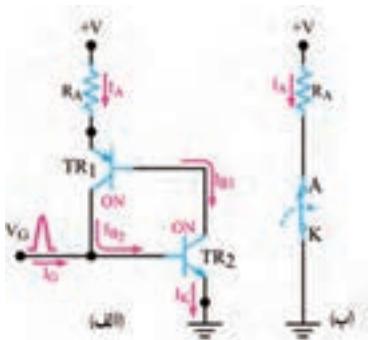
(الف) با اعمال V_G مقدار جریان بیس ترانزیستور TR_2 یعنی I_{B2} افزایش می‌یابد.

(ب) با زیاد شدن I_{B2} مقدار I_{C2} زیاد می‌شود.

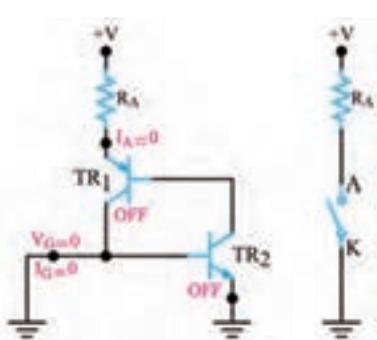
(پ) چون $I_{C2} = I_{B1}$ است، با افزایش I_{C2} مقدار I_{B1} زیاد می‌شود.

(ت) با زیاد شدن I_{B1} مقدار جریان I_{C1} افزایش می‌یابد.

(ث) چون $I_{C1}=I_{B2}$ است با زیاد شدن I_{B2} مقدار I_{C1} مجدداً زیاد می‌شود و دوره عملیات تکرار می‌گردد. در شکل الف - ۸۶ هدایت ترانزیستورهای TR_1 و TR_2 در شکل ب - ۸۶ در مدار معادل آن به صورت یک کلید بسته، نشان داده شده است.



شکل ۸۶



شکل ۸۵

حالت سوم – قطع پالس تحریک (تریگر V_G): با قطع پالس تحریک (تریگر V_G) همچنان در ناحیه فعال باقی می‌ماند و آند و کاتد آن مانند یک کلید بسته عمل می‌کند.

مزایای دیگر رله جامد

از دیگر مزایای رله‌های جامد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

قطع و وصل رله‌های جامد بسیار سریع تر از رله‌های الکترومکانیکی و کنتاکتورها بوده و زمان سویچینگ آنها، در حد میکروثانیه یا میلی ثانیه است.

چون در زمان قطع و وصل جرقه ایجاد نمی‌کنند، برای مکان‌هایی که گازها و مواد قابل اشتعال و انفجار وجود دارد، مناسب است.

به دلیل نداشتن قطعات متحرک در برابر لرزش و ضربه مقاوم تر از رله‌های الکترومکانیکی هستند.

اندازه کوچک‌تری دارند.

● **انواع رله‌های جامد از نظر نوع ولتاژ فرمان و سوئیچ:**

۱ رله با ولتاژ کنترل DC و خروجی DC

۲ رله با ولتاژ کنترل DC و خروجی AC

۳ رله با ولتاژ کنترل AC و خروجی DC

۴ رله با ولتاژ کنترل AC و خروجی AC

همچنین رله‌های جامد به صورت تک فاز و سه فاز نیز تولید می‌شوند.

بخش ۳

نکات مربوط به کتاب مونتاژ و دمونتاژ SMD

- ۱ دمونتاژ قطعات SMD
- ۲ مونتاژ قطعات SMD
- ۳ دیجیتال و کاربرد آن
- ۴ میکروکنترلرها
- ۵ مستندسازی

فصل اول: دمونتاز قطعات SMD

هویه



شکل ۸۷- هویه هوای گرم



شکل ۸۸- قسمت داخلی هیتر



شکل ۹۰- مولد هوای فشرده (کمپرسور) پا به

- مدار داخلی هویه هوای گرم (هیتر)
 - ✓ در طول تعمیرات بردهای الکترونیکی ممکن است به تجهیزات دمونتاز آسیب وارد شود. آشنایی با این قسمت‌ها جهت درک بهتر نحوه عملکرد دستگاه و آموزش نیز تعمیر دستگاه بسیار مؤثر است. شکل‌های ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ هیتر باز شده و قسمت‌های داخلی آن را نشان می‌دهد.



شکل ۸۹- برد الکترونیکی و کنترل

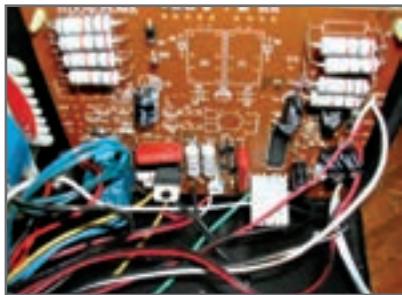
- ✓ قسمت‌های مختلف یک نوع هیتر دیگر با نشان دادن اجزای داخلی آن در فرایند تعمیرات را در شکل‌های ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ مشاهده می‌کنید.



شکل ۹۲- جداسازی مولد هوای فشرده (کمپرسور)



شکل ۹۱- باز شدن پوشش دستگاه



شکل ۹۴- برد الکترونیکی و کنترل شدت هوای فشرده



شکل ۹۳- برد الکترونیکی و کنترل درجه حرارت



شکل ۹۶- اجزای داخلی کمپرسور

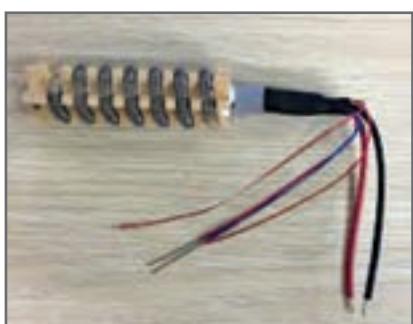


شکل ۹۵- مولد هوای فشرده (کمپرسور)

در شکل های ۹۷ و ۹۸ مدار گسترش قطعات داخلی و اجزای دسته هیتر را ملاحظه می کنید.



شکل ۹۸- اجزای داخلی کمپرسور



شکل ۹۷- اجزای داخلی کمپرسور

خازن ها

● کدگذاری و کاربرد خازن ها

خازن انواع مختلفی دارد. برای هر رنج مشخص از یک نوع خازن استفاده می شود. در شکل ۹۹ موارد استفاده از انواع خازن با توجه به حوزه کار (Range)، جنس، شکل ظاهری و ظرفیت آورده شده است.

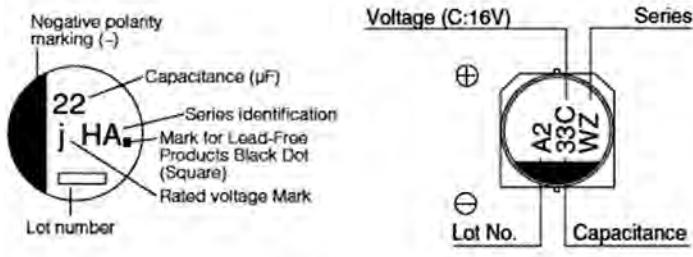
- برای آشنایی کامل با کدگذاری خازن‌ها، در اینترنت کلمه capacitor code chart را جستجو کنید. سایت‌های مرتبط با کدگذاری خازن‌ها در دسترس قرار می‌گیرند.
- خازن انواع مختلفی دارد و برای هر رنج مشخص از یک نوع خازن استفاده می‌شود.

= Type polarized	Pic	Cap Range
Ceramic		pF - μF
Mica (silver mica)		pF - nF
Plastic Film (polyethylene polystyrene)		few μFs
Tantalum		μFs
OSCON		μFs
Aluminum Electrolytic		high μFs

شکل ۹۹- جدول کاربرد خازن

• خواندن کد خازن الکتروولیتی

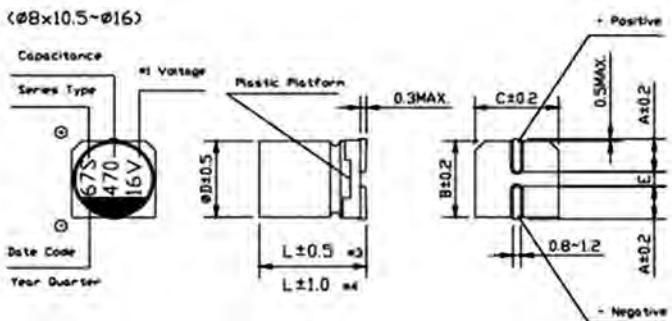
- به طور کلی روی خازن‌ها قطب منفی یا مثبت، ظرفیت خازن، ولتاژ و اطلاعاتی در زمینه شرکت سازنده آن نوشته می‌شود. در شکل ۱۰۰ نمونه‌ای از این کدگذاری را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۰۰- کدگذاری خازن‌های الکتروولیتی

جهت دریافت اطلاعات دقیق‌تر می‌توان به دیتاشیت این خازن‌های الکتروولیتی رجوع کرد.
نمونه‌ای از دیتاشیت خازن الکتروولیت SMD در شکل ۱۰۱ آمده است.

SS Series



DHL	Φ4×5.4	Φ5×5.4	Φ6.3×5.4	Φ6.3×7.7	Φ8×6.2	Φ8×10.5	Φ10×10.5	Φ10×13.5	Φ12.5×13.5	Φ12.5×16	Φ16×16.5
A	1.8	2.1	2.4	2.4	3.3	2.9	3.2	3.2	4.7	4.7	5.5
B	4.3	5.3	6.6	6.6	8.3	8.3	10.3	10.3	13.0	13.0	17.0
C	4.3	5.3	6.6	6.6	8.3	8.3	10.3	10.3	13.0	13.0	17.0
E ± 0.2	1.0	1.3	2.2	2.2	2.2	3.1	4.4	4.4	4.4	4.4	6.7
L	5.6	5.4	5.4	7.7	6.2	10.5	10.5	13.5	13.5	16.0	16.5

۱۰۱—دیتا شیت خازن الکتروولیت

معرفی نرم افزار اندروید

نرم افزارهای بسیاری برای شناسایی و محاسبه کد قطعات SMD وجود دارد که به چند نمونه از آن اشاره می‌شود:

● نرم افزار SMD Decypher

این نرم افزار از قدرتمندترین نرم افزارهای موجود در این زمینه است. با استفاده از این نرم افزار می‌توانید اطلاعات قطعات، شامل بسته‌بندی (پکیج - package)، شرکت سازنده، نمایش پایه‌های قطعه و دریافت دیتاشیت آنها به دست آورید. شکل های ۱۰۲ محیط نرم افزار را نشان می‌دهد.



۱۰۲—فضای نرم افزار اندروید

• نرم افزار smd code

نرم افزار SMD code نیز یکی از نرم افزارهای مفید برای شناسایی و دریافت اطلاعات در مورد قطعات مختلف SMD از جمله آی سی های مختلف است. شکل ۱۰۳ قسمت هایی از محیط نرم افزار را نشان می دهد.

در برگه اطلاعات این نرم افزارها مشخصات دقیق شامل مواردی مانند شکل ظاهری، شماره پایه ها و کارخانه سازنده داده می شود، شکل ۱۰۴.



۱۰۳ - فضای نرم افزار

Search

SMD code: 01N60C3

Type: SPN01N60C3

SMD code: 02N60C3

Type: SPN02N60C3

SMD code: 02N60S5

Type: SPN02N60S5

SMD code: 03N60C3

Type: SPN03N60C3

SMD code: 03N60S5

Type: SPN03N60S5

SMD code: 0410

Type: SSM0410

Smd code: AEF

Manufactured: Maxim Integrated Products

Tip: MAX9718DEBL-TG45

Function: Linear integrated circuit

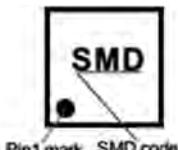
Case: BGA-9

Short description: Audio Frequency Powerer

Amplifier, Bridge Tied Loads,

2.7..5.5V, 1.4W(5V/4Ω), select

shutdown



SMD code: 03N60C3

Manufactured: Infineon Technologies AG

Tip: SPN03N60C3

Functions: n-MOSFET

Case: SOT-223

Short description: High Voltage, Logic Level (Uth > 0/8 ... 2V), 650V, 700mA, 1.8W,

1.2Ω(2A), 7/64ns



۱۰۴ - مشخصات قطعات نرم افزار